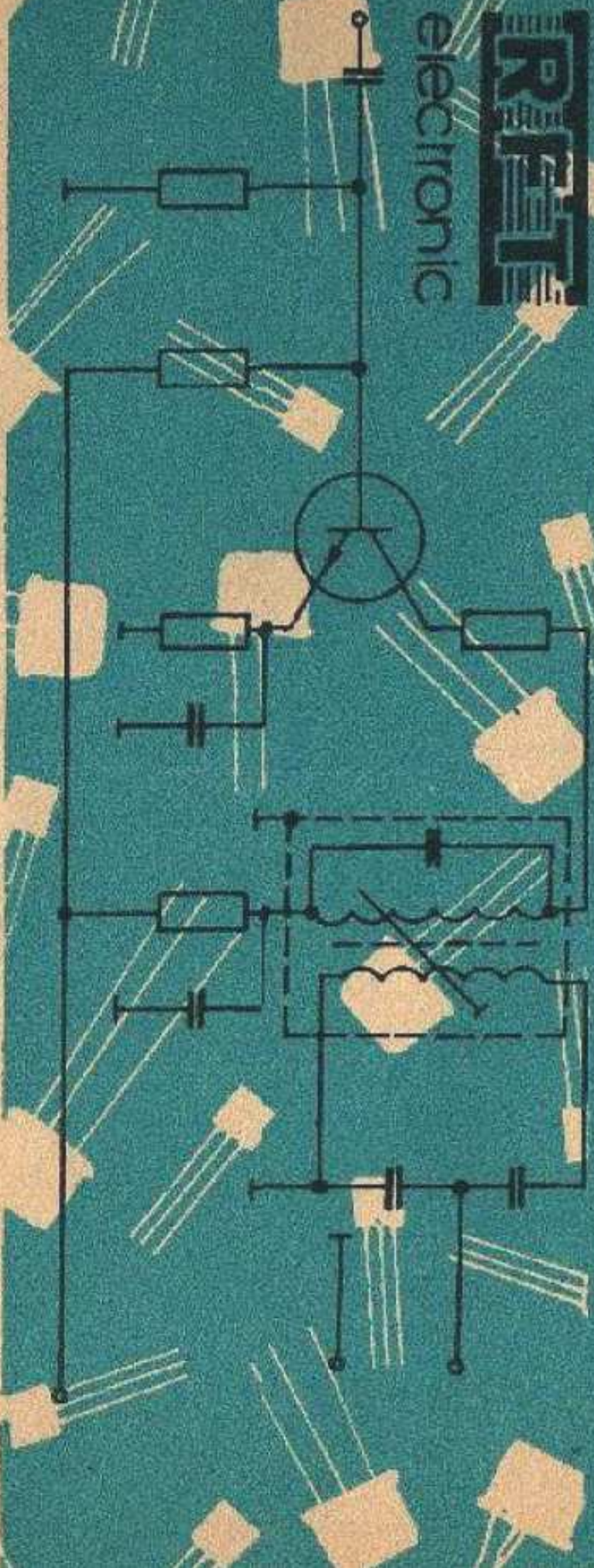


HAVIBBINTNER

REIT
electronic

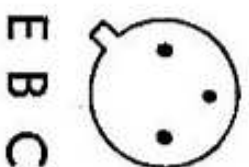
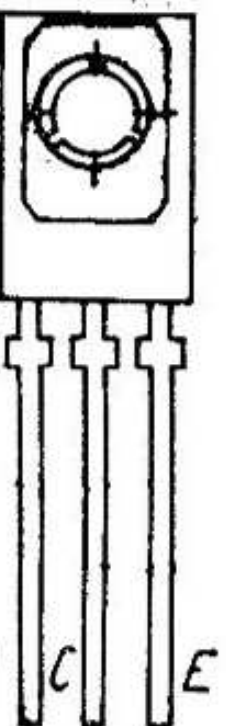


BASTLERBUCH, 9

Inhalt

- a) 1 Stück Miniplasttransistor (für geregelte ZF-Stufen)
- b) 5 Stück Miniplasttransistoren (für ungerelgte ZF-Stufen)
- c) 4 Stück Miniplasttransistoren (für HF-Verstärker, Vor- und ZF-Stufen)
- d) 2 Stück Silizium-npn-Transistoren (für höhere Betriebsspannungen)

Anschlußschema:



- a) ohne Kennzeichnung
- b) 1 Farbpunkt
- c) 2 Farbpunkte
- d)

d)

Daten der Transistoren

a), b), c)

Reststrom	$I_{CBO} \leq 500 \text{ nA}$	bei $U_{CB} = 20 \text{ V}$
Durchbruchsspannung	$U_{(BR)CEO} \geq 12 \text{ V}$	bei $I_C = 1 \text{ mA}$
Stromverstärkung	$h_{21E} \geq 5$	bei $U_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_C = 10 \text{ mA}$

d)

Reststrom	$I_{CBO} \leq 100 \text{ nA}$	bei $U_{CB} = 100 \text{ V}$
Reststrom	$I_{CER} \leq 5 \text{ mA}$	bei $U_{CER} = 100 \text{ V}$ $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$
Stromverstärkung	$h_{21E} \geq 8$	bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 5 \text{ mA}$

Hinweise

Die im Bastlerbeutel enthaltenen Miniplasttransistoren sind speziell für den Einsatz im geregelten und ungeregelten ZF-Verstärker für Frequenzen bis etwa 40 MHz vorgesehen.

Gute Ergebnisse kann man auch bei anderen Anwendungen bis 200 MHz erzielen:

- z. B.:
- Mischstufen
 - Breitbandverstärker für UKW
 - Treiberstufen für Transistorsender

Diese Transistoren sind in Ermitterschaltung einzusetzen.

Die unter d) ausgewiesenen Si-Transistoren können in Videoendstufen und Regelnetzteilen für höhere Spannungen eingesetzt werden.

Halbleiter – Bastlerbeutel – Sortiment

1 NF-Schaltungen

Inhalt: 14 NF-Transistoren

50–400 mW

2 HF-Schaltungen

Inhalt: 10 HF- und UKW-Transistoren

3 NF-Leistungstransistor-Schaltungen

Inhalt: 5 NF-Leistungstransistoren

1–10 W

4 Gleichrichterdioden

Inhalt: 12 Ge- bzw. Si-Gleichrichterdioden

0,1–1 A

5 Leistungsgleichrichterdioden

Inhalt: 4 Si-Leistungsgleichrichterdioden

10 A

6 Si-Miniplasttransistoren

Inhalt: 20 HF- und Schalttransistoren

200 mW

7 Si-Transistoren im Metallgehäuse

Inhalt: 12 HF- und Schalttransistoren

300–600 mW

8 Digitale Integrierte Schaltkreise

Inhalt: 8 Integrierte Schaltkreise für die Anwendung in der Digitaltechnik

12 Siliziumtransistoren für ZF- und HF Schaltungen

EVP: 7,55 Mark



VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS

im VEB Kombinat Mikroelektronik

6420 Neuhaus am Rennweg

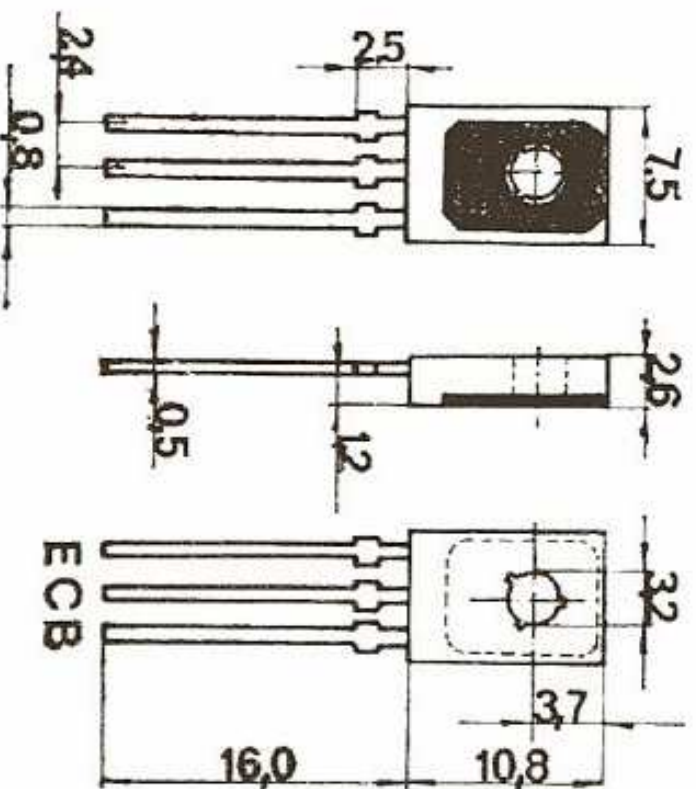
Thomas-Mann-Straße 2

Telefon 50

4.8. Juni 1982

Микроелектроник

Halbleiter-Bastlerbeutel 9/1



12 Si-npn-Transistoren

EVP 11,00 M



veb mikroelekttronik,anna seghers,neuhaus
im veb kombinat mikroelekttronik

Inhalt: 12 Stück Si-npn-Transistoren
für höhere Sperrspannungen

Kennzeichnung: TV

Daten der Transistoren:

$I_{CBO} \leq 100 \text{ nA}$ bei $U_{CB} = 100 \text{ V}$

$I_{CER} \leq 5 \text{ mA}$ bei $U_{CER} = 100 \text{ V}$, $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$

$h_{21E} \geq 20$ bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 5 \text{ mA}$

$U_{(BR)EBO} \geq 4 \text{ V}$ bei $I_E = 10 \mu\text{A}$

$P_{tot} = 1,2 \text{ W}$ bei 25°C Umgebungstemperatur

3

H.J. Der 1989

veb mikroelektronik > anna seghers < neuhaus
im veb kombinat mikroelektronik

Telefon 50, Thomas-Mann-Straße 2, Neuhaus am Rennweg, DDR - 6420

dzi 1259-E-V2-11-Sd106-88